

### Э Т И К Е Т К А

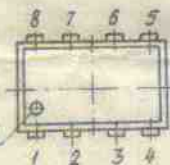
Микросхемы типа КР159НТ1А, КР159НТ1Б,  
 КР159НТ1В, КР159НТ1Г, КР159НТ1Д, КР159НТ1Е  
 соответствуют ГОСТ 18725-73 и техническим  
 условиям 3.456.006 ТУ

### БАЗОВАЯ СХЕМА ДИМЕРЕНЦИАЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ

Схема расположения выводов  
 (нумерация выводов дана условно)

Таблица назначения  
 выводов

Вывод	Назначение
2	Коллектор VT1
3	База VT1
4	Эмиттер VT1
5	Эмиттер VT2
6	База VT2
7	Коллектор VT2



КЛЮЧ

Масса не более 1,0 г.

Содержание драгоценных металлов  
 в 1000 шт микросхем  
 золото

0,2100МГ-Зл999,9

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ  $t = (25 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Типовым	Норма	
			не менее	не более
Обратный ток коллектора, нА $I_{КБ} = 20 \text{ В}$	$I_{КБ}$	KP159HT1A- KP159HT1E	-	200
Обратный ток эмиттера, нА $U_{ЗБ} = 4 \text{ В}$	$I_{ЭБ}$	KP159HT1A- KP159HT1E	-	500
Ток утечки между транзисторами, нА $U_{Т1Т2} = 20 \text{ В}$	$I_{Т1Т2}$	KP159HT1A- KP159HT1E	-	20
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером $U_{КБ} = 5 \text{ В}, \tau_U = 2 \text{ мс}$ $I_3 = 1,0 \text{ мА}$ $I_3 = 0,05 \text{ мА}$	$h_{213}^{**}$	KP159HT1A, KP159HT1Г	20	80
		KP159HT1Б, KP159HT1Д	60	160
		KP159HT1В, KP159HT1Е	80	-
		KP159HT1А, KP159HT1Б	0,35*	-
Отношение статических коэффициентов передачи тока в схеме с общим эмиттером $U_{КБ} = 2 \text{ В}, \tau_U = 2 \text{ мс}$ $I_3 = 1,0 \text{ мА}$ $I_3 = 0,05 \text{ мА}$	$h_{213}^{**}$ $h_{213}^{**}$	KP159HT1Г, KP159HT1Д	0,75	-
		KP159HT1В, KP159HT1Е	0,35	-
		KP159HT1В, KP159HT1Е	0,75	-
		KP159HT1А, KP159HT1Б	2,0	-

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте

$U_{КБ} = 5 \text{ В}, I_3 = 3,0 \text{ мА},$   
 $f = 10^6 \text{ Гц}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Типовым	Норма	
			не менее	не более
Модуль разности прямых амплитуд на коллекторе эмиттер-база, мВ $U_{КБ} = 5 \text{ В}, I_3 = 1,0 \text{ мА}$	$U_{ЗБ1} - U_{ЗБ2}$	KP159HT1A, KP159HT1Б, KP159HT1Г, KP159HT1Д, KP159HT1Е	-	3
Примечания: * За $h_{2131}$ принимается значение параметра транзистора с меньшим коэффициентом передачи тока. ** Норма $h_{213}$ задана для транзистора микросхемой с большим значением этого параметра. *** Для изделий с ГСР $h_{213} / h_{2131} \geq 2,5$				

ОТК

